



บทที่ ๒.

การออกแบบและการสร้างเครื่องวัดความหนาชั้น SiO₂

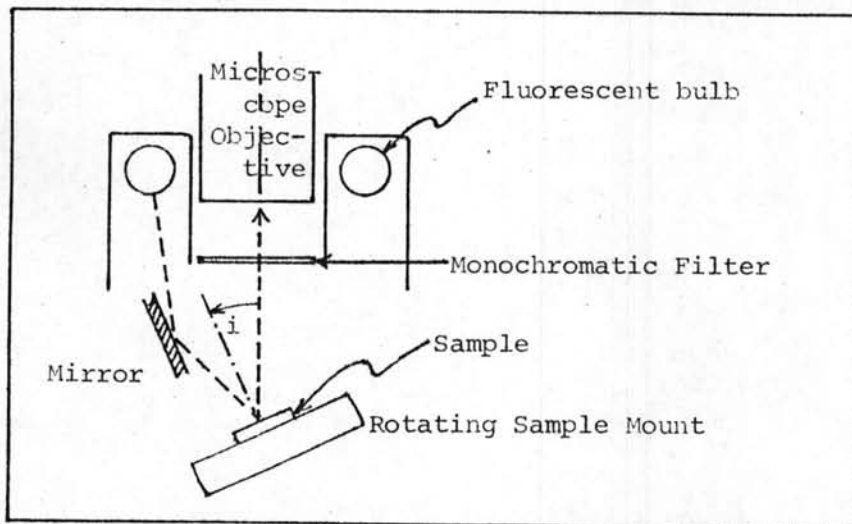
การวัดความหนาชั้น SiO₂ทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่เหมาะสมจะนำมาออกแบบสร้างเครื่องวัดคือวิธี VAMFO. ดังได้กล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ ๑.

ในบทนี้กล่าวถึง การออกแบบสร้างเครื่องวัดความหนาชั้น SiO₂ ด้วยวิธี VAMFO. โดยใช้แสงสีเดียว (Monochromatic light) จาก He - Ne Laser อันจะทำให้รูปแบบของเครื่องวัดเปลี่ยนไป และความซับซ้อนน้อยลง

006505

รูปแบบเครื่องมือทั่วไป

เครื่องวัดความหนาชั้น SiO₂ ด้วยวิธี VAMFO. ทั่วไปมีส่วนประกอบสำคัญ ๆ คือ หลอด Fluorescent กระจกเงาสท้อนแสง แท่นติดตั้งแว่นผลึกปรับมุมได้ แผ่นกรองแสงสีเดียว (Monochromatic Filter) และกล้องจุลทรรศน์ โดยประกอบกันอยู่ดังรูป ๒.๑



รูป ๒.๑

แสดงส่วนประกอบสำคัญของเครื่องวัด

VAMFO. โดยทั่วไป

(6)

การวัดทำได้โดย ผู้สังเกตปรับกระจกเงาให้แสงจากหลอด Fluorescent ส่องกระทบแว่นผลึก โดยให้แสงนี้สะท้อนจากแว่นผลึกเข้าสู่กล้องจุลทรรศน์ ในขณะที่เดียวกันก็ปรับมุมของแว่นผลึกไปด้วย มุมตกกระทบอ่านได้จาก dial ที่ติดกับแกนหมุนของแท่นติดตั้งแว่นผลึก แสงที่ตกตั้งฉากกับกล้อง

จุดศันจะถูกกรองด้วย แผ่นกรองแสงสีเดียว เพื่อให้เกิดปรากฏการณ์เสริมและหักล้างกันของคลื่น จึงจะสังเกตเห็น fringe ได้

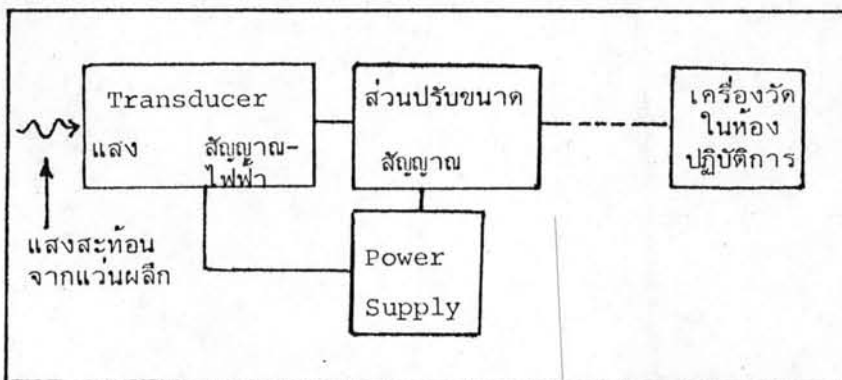
เครื่องมือนี้ มีข้อดีคือ เปลี่ยนความถี่ของแสงสีเดียวได้ง่ายโดยเพียงแต่เปลี่ยนแผ่นกรองแสงสีเดียวเท่านั้น เครื่องมือจึงไม่มีช่วงที่เป็นจุดบอด ข้อเสียคือ การวัดไม่สะดวก เครื่องมือซับซ้อน และราคาแพง ข้อบกพร่องนี้จะยึด เป็นข้อปรับปรุงในการออกแบบ เครื่องมือชิ้นใหม่

การออกแบบ เครื่องมือ

เครื่องมือที่ออกแบบนี้ กำหนดให้ He-Ne Laser เป็น Monochromatic light source ซึ่งมีข้อดีคือให้แสงที่มีความเข้มสูง และ เกือบ เป็นแสงสีเดียวในอุดมคติมีความยาวคลื่น 6328 \AA จึงสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์ด้วยตาเปล่าได้ชัดเจน จึงตัดความจำเป็นในการใช้กล้องจุลทรรศน์และแผ่นกรองแสงสีเดียวออกได้

เพื่อให้การวัดสะดวกและรวดเร็ว จึงออกแบบ เครื่องวัดที่วัดได้ต่อเนื่อง ในขณะที่เปลี่ยนมุมตกกระทบไป และการวัดความเข้มของแสงที่สะท้อนจากแว่นผลึกใช้ Electronic Detector การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของเครื่องมือแยกกล่าวได้ดังนี้

Electronic Detector ส่วนนี้เปลี่ยนความเข้มของแสงสะท้อน เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อสะดวกในการวัดด้วย เครื่องวัดที่มีในห้องปฏิบัติการ ส่วนนี้มี Block Diagram ดังรูป ๒.๒



รูปที่ ๒.๒

Block diagram ของ
Electronic Detector

Transducer ที่ใช้ในการเปลี่ยนความเข้มแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าคือ Photo Transistor

No. 2N5777 มีข้อกำหนดดังรูป ๒.๓

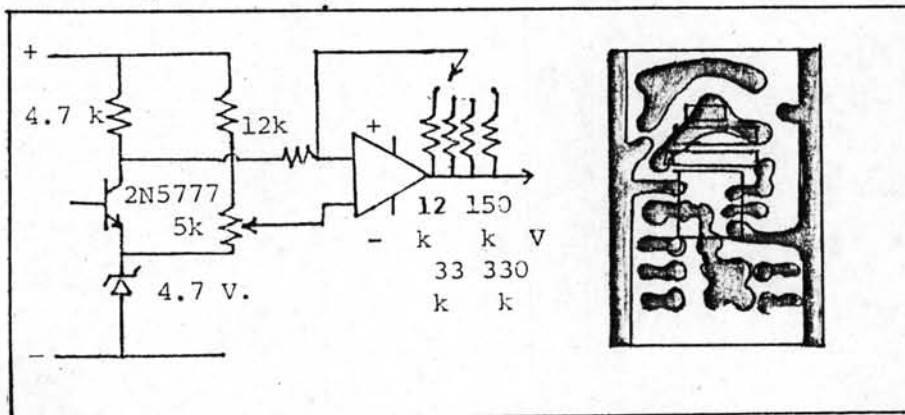
Material	Polarity	Pd. (mw.)	T _j (°C)	V _{cb}	V _{ceo}
Si	N	200	100	25	25

Current at light intensity = 2 mw./cm ² (mA.)	
4	

รูปที่ ๒.๓

ข้อกำหนดของ
2N5777

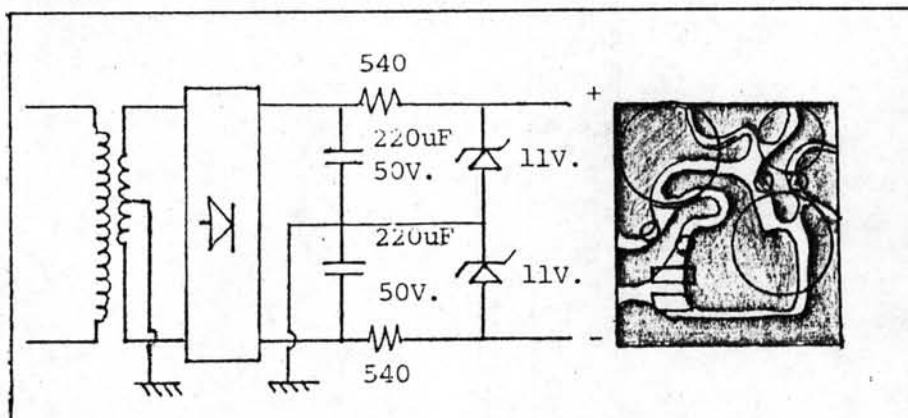
การออกแบบในส่วนนี้ต้องออกแบบให้ส่วนรับแสงมีขนาดแคบที่สุด เพื่อจะได้ไม่บังแสงตกกระทบ เมื่อมุมตกกระทบมีค่าน้อย ๆ ดังนั้นจึงต้องแยก Photo Transistor ออกจากแผ่นวงจร เพื่อลดขนาดของส่วนรับแสงลง วงจรและแผ่นวงจรของส่วนนี้รวมอยู่กับส่วนปรับและขยายสัญญาณ ดังแสดงในรูป ๒.๔



รูปที่ ๒.๔

วงจรและแผ่นวงจร
ของส่วนปรับขนาด
สัญญาณ

ทางด้าน Power Supply ออกแบบให้ใช้ได้กับไฟ AC. 220 V. จึงต้องออกแบบส่วนนี้ประกอบด้วยโดยแยกจากส่วนรับและขยายสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวน วงจรและแผ่นวงจรแสดงไว้ในรูป ๒.๕

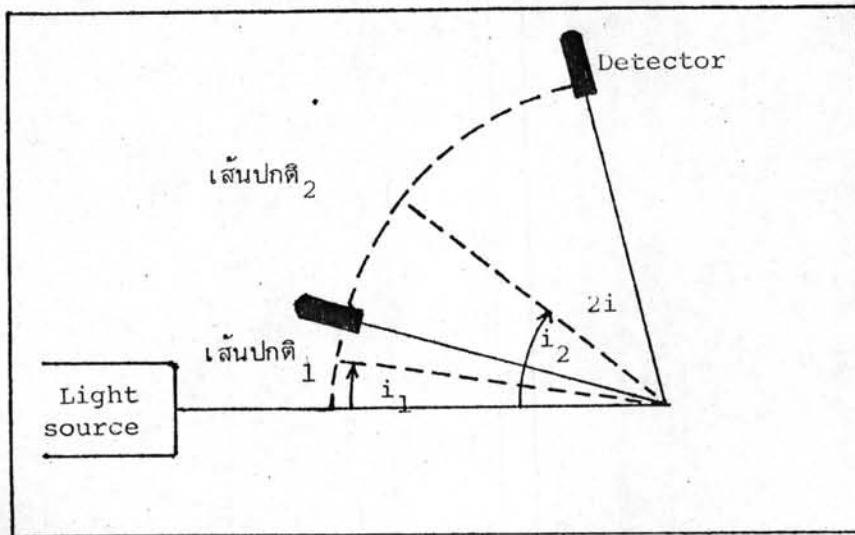


รูปที่ ๒.๕

วงจรและแผ่นวงจร
ของ Power
Supply

Electronic Detector ที่สร้างขึ้นนี้มีขนาดเล็ก และอ่านค่าความเข้มแสงได้สะดวกกว่า
การมองด้วยตามาก

ส่วนบังคับให้แสงสะท้อนตกลงบน Detector ตลอดเวลา การออกแบบส่วนนี้เป็นการ
ปรับปรุงจากเครื่องวัดทั่ว ๆ ไป เพื่อให้ใช้วัดต่อเนื่อง จึงวัดได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้
กระจกเงาปรับแสง ข้อกำหนดในการออกแบบส่วนนี้คือ He-Ne Laser ที่ใช้เป็น light source
มีขนาดใหญ่จนน้ำหนักมาก และทนการกระแทกกระแทกไม่ได้ จึงต้องติดตั้งอยู่กับที่ การเปลี่ยนมุมตก
กระทบ ทำได้โดยหมุนแวนผลึกรอบตำแหน่งที่แสงตกกระทบ ดังนั้น Detector ต้องหมุนไปรอบ
แกนเดียวกันโดยทำมุม ๒ เท่าของมุมตกกระทบเสมอ เพื่อการวัดที่ต่อเนื่อง ดังแสดงในรูป ๒.๖

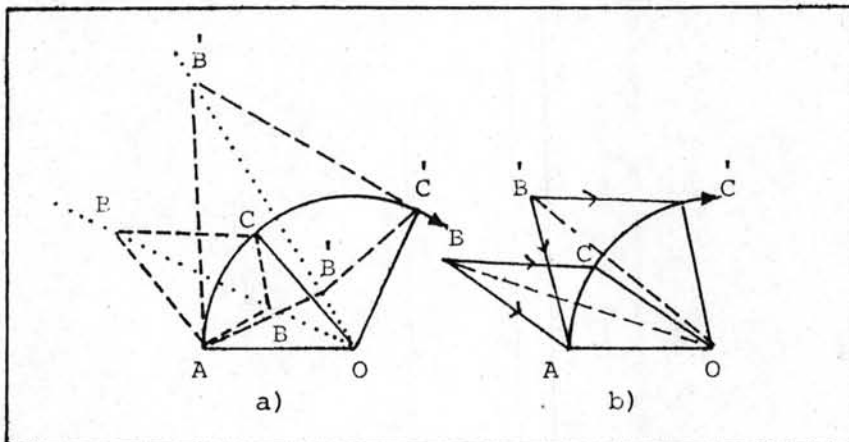


รูป ๒.๖

ข้อกำหนดการวัดต่อ-
เนื่อง

การออกแบบเครื่องมือให้ทำงานได้ตามข้อกำหนด สามารถวิเคราะห์ได้จากรูปเรขาคณิต

ในรูป ๒.๗



รูป ๒.๗

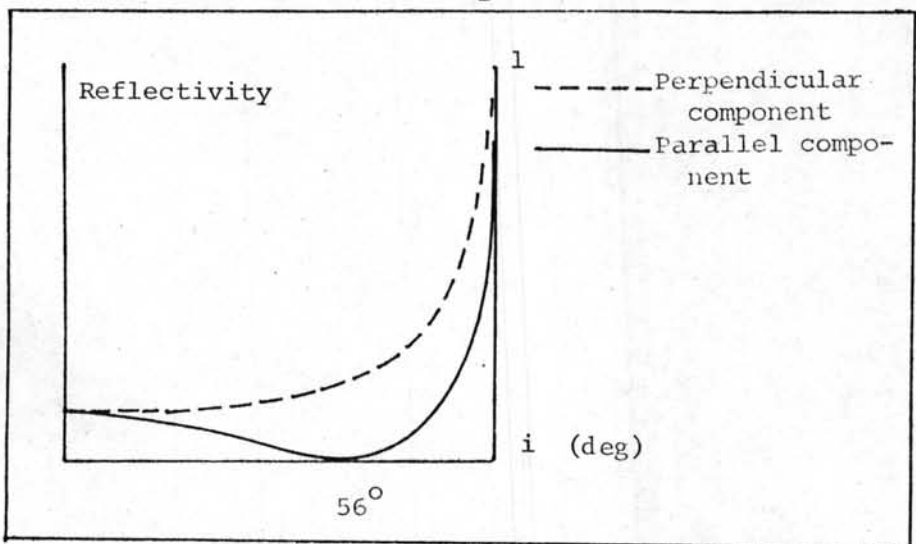
รูปเรขาคณิตวิเคราะห์
ในการออกแบบเครื่องมือ

จากรูป ๒.๗ a) C เคลื่อนที่ออกจาก A เป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลาง O, B เป็นจุด
ใด ๆ ที่เส้นแบ่งครึ่งมุม AOC ย่อมมีระยะ AB = BC เสมอ

ดังนั้นถ้ากำหนดให้ AB = BC แล้ว BO จะแบ่งครึ่งมุม AOC เสมอดังรูป ๒.๗ b)

จากคุณสมบัติดังกล่าวนี้ถ้าให้ A O B เป็นมุมตกกระทบของแสงที่ส่องในแนว A O แสงสะท้อน
ต้องอยู่ในแนว O C เสมอ และเส้นปกติของแฉกผลึกจะอยู่ในแนว O B ดังนั้นถ้าขังขั้วให้แฉก
ผลึกหมุนตามแนว O B และติดตั้ง Detector ที่จุด C ก็สามารถวัดความเข้มของแสงสะท้อนจาก
แฉกผลึกอย่างต่อเนื่องไม่ว่า C จะอยู่ที่ตำแหน่งใดบนเส้นรอบวงของวงกลม O ข้อมูลนี้สามารถ
นำไปใช้ออกแบบสร้างเครื่องมือได้

นอกจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว มุมตกกระทบสูงสุดที่สามารถเกิด fringe ได้นั้นถูก
กำหนดด้วยคุณสมบัติทางแสงของชั้น SiO₂ คือ Reflectivity ดังรูป ๒.๘ (7)



รูปที่ ๒.๘

Reflectivity
ของ SiO₂

พิจารณาจากกราฟของ Reflectivity เห็นได้ว่า การสะท้อนของ Parallel
Component จะลดลงเป็น 0 ที่มุมตกกระทบหนึ่งเรียกว่า Brewster angle (θ_B) โดย

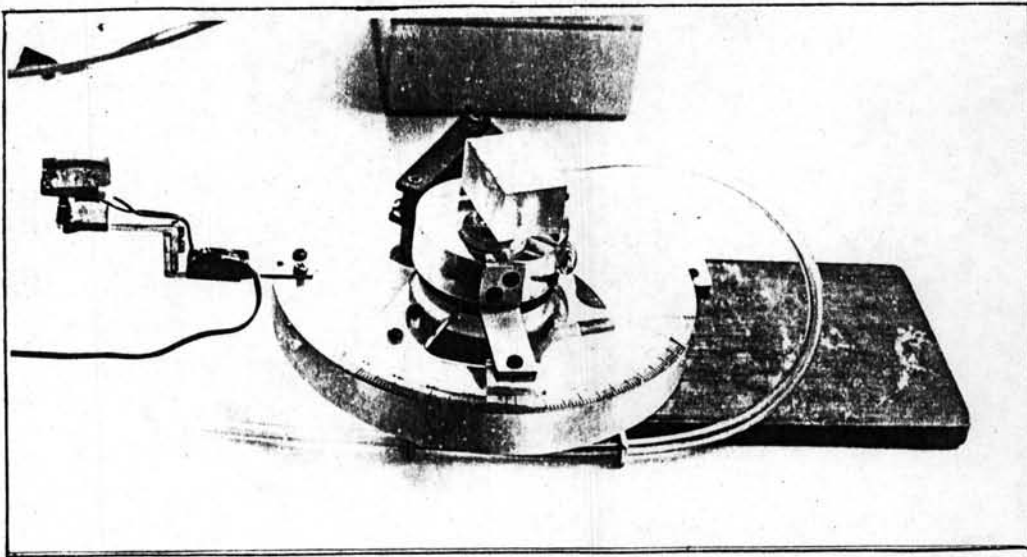
$$\theta_B = \tan^{-1} \theta_i = \frac{\mu_2}{\mu_1} = \mu_2$$

เมื่อ μ_1 และ μ_2 คือดัชนีหักเหของอากาศและ SiO₂ ตามลำดับ

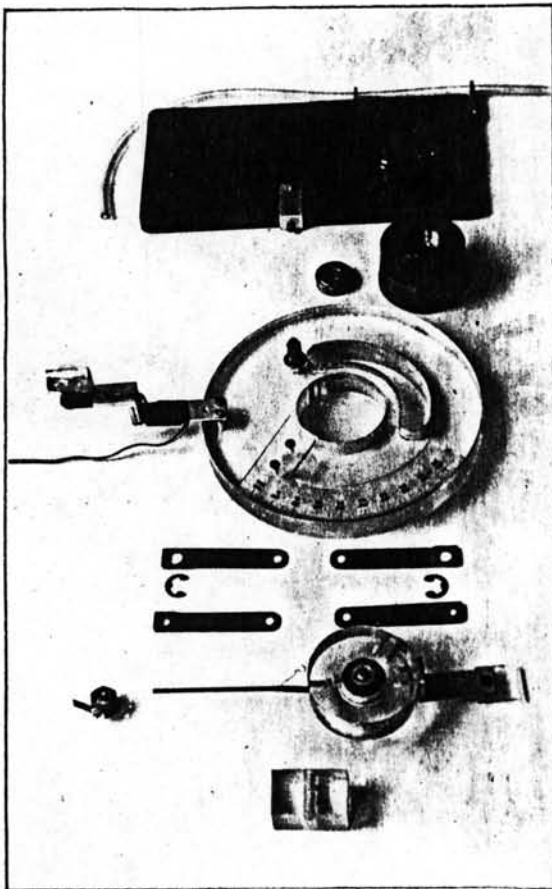
ถ้า m ประมาณ ๑.๕ จะได้ θ_B ประมาณ ๕๖° ถ้ามุมตกกระทบมากกว่า θ_B phase ของ parallel component จะเปลี่ยนไป ๑๘๐° ดังนั้นถ้าไม่ใช้ Polarizer คัด parallel component ออก fringe จะถูกรบกวนจนไม่สามารถสังเกตเห็นได้ (6) ในทางปฏิบัติจึงออกแบบให้ปรับมุมตกกระทบได้ตั้งแต่ $๐-๖๐^\circ$ ก็นับเป็นการเพียงพอ

การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือที่ออกแบบสร้างขึ้นนี้ เป็นการวัดทางแสงดังนั้นความสะอาดของเครื่องมือจึงเป็นส่วนสำคัญต่อความแม่นยำในการวัด และวัสดุที่ใช้ควรมีน้ำหนักมากพอควรเพื่อป้องกันการเลื่อนตำแหน่งในขณะวัด จึงเลือกทองเหลืองเป็นวัสดุในการสร้างฐาน และแผ่น Acrylic ใสในส่วนที่ต้องการความสะอาดสูง

ด้วยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ทั้งหมดนี้ นำมาประกอบกันเพื่อสร้างเครื่องวัดความหนาชั้น SiO_2 ได้โดยมีลักษณะดังรูป ๒.๔



รูปที่ ๒.๔ ก. รูปถ่ายของเครื่องวัดที่ออกแบบขึ้น



รูปที่ ๒.๔ ข. รูปถ่ายแยกส่วนของเครื่องวัด